

信頼性試験結果 Reliability Test Result		ローム株式会社 パワートランジスタ事業部 ROHM Co., Ltd. Power Transistor Division	
作成日(DATE)	2022年6月30日 30-Jun-22	品名(product)	MOS
管理No.(Serial No.)	3022008	形名, PKG (Type)	R6020ENX(TO-220FM)

1. 試験結果(TEST RESULT)				
試験項目 (TEST ITEM)	試験条件 (TEST CONDITION)	準拠規格 (STANDARD)	n[pcs] (Sample QTY.)	Pn[pcs] (NG QTY.)
温度サイクル Temperature cycle	-55±5°C←→150±5°C 100サイクル -55±5°C←→150±5°C 100cycles	JESD22-A104	22	0
高温高湿逆バイアス High temp. high humidity reverse bias	85±2°C, 85±5%RH, 規定のバイアス, 1000時間 85±2°C, 85±5%RH, specified bias, 1000hours	JESD22-A101	22	0
飽和蒸気加圧 PCT Pressure cooker test	121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100時間 121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100hours	JESD22-A102	22	0
高温逆バイアス High temperature reverse bias	Ta=Tstg max, 規定のバイアス, 1000時間 Ta=Tstg max., specified bias, 1000hours	JESD22-A108	22	0
高温ゲートバイアス High temperature gate bias	Ta=Tstg max, V _{GSS} (max), 1000時間 Ta=Tstg max, V _{GSS} (max), 1000hours	JESD22-A108	22	0
高加速温湿度ストレス HAST Highly Accelerated Stress Test	130±2°C, 85±5%RH, 規定のバイアス, 100時間 130±2°C, 85±5%RH, specified bias, 100hours	JESD22-A110	22	0

2. 測定項目及び故障判定基準(FAILURE CRITERIA)		
測定項目 (ITEM)	測定条件 (CONDITION)	故障判定基準 (CRITERIA)
ゲート漏れ電流 : IGSS Gate-Source Leakage : IGSS	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within the two times of the standard value.
ドレイン遮断電流 : IDSS Zero Gate Voltage Drain Current : IDSS	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within the two times of the standard value.
順電圧アドミタンス : Y _{fs} Forward Transfer Admittance : Y _{fs}	仕様書条件による Per specification	初期値に対する変化率 ±20% Changing rate of ±20%
外観 Physical	目視 Visual check	著しい変化のないこと No outstanding change in physical.

3. 判定結果(JUDGEMENT)
各試験項目とも不具合の発生は認められておりません。 No failure is observed from each test item.
MOS(SOT-416(EMT3))